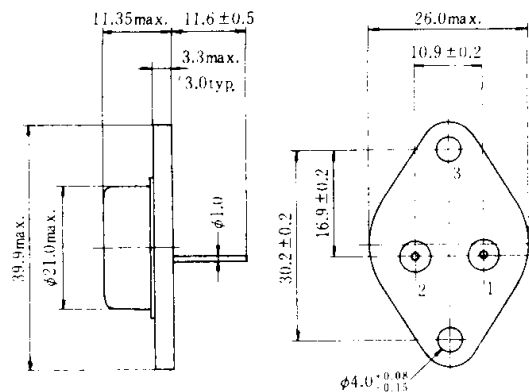


2SD801, 2SD802

シリコンNPN三重拡散形
高速度高電流スイッチング用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED
HIGH SPEED AND HIGH CURRENT SWITCHING



- 1. ベース: Base
 - 2. エミッタ: Emitter
 - 3. コレクタ: Collector
(ケース) (Case)
- (Dimensions in mm)

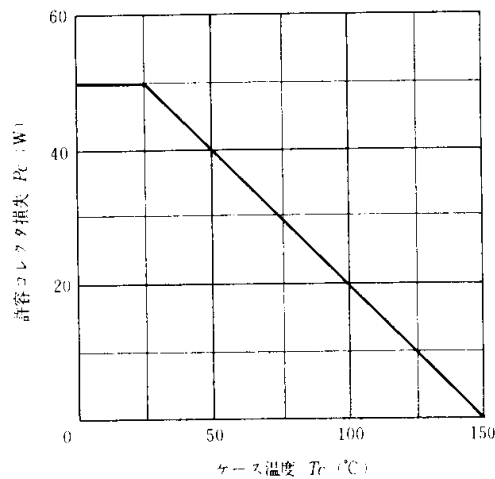
(JEDEC TO-3)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SD801	2SD802	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	800	900	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	375	400	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	7	V
コレクタ電流	I_C	6	6	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}^*$	8	8	A
ベース電流	I_B	2	2	A
許容コレクタ損失	P_C^{**}	50	50	W
接合部温度	T_j	150	150	$^\circ\text{C}$

- * $t < 1\text{ms}$ における許容値
- ** $T_c = 25^\circ\text{C}$ における許容値
- * Value at $t < 1\text{ms}$
- ** Value at $T_c = 25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	2SD801			2SD802			Unit
			min	typ	max	min	typ	max	
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_C = 0.1\text{mA}, I_E = 0$	800	—	—	900	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 10\text{mA}, R_{BE} = \infty$	375	—	—	400	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 5\text{mA}, I_C = 0$	7	—	—	7	—	—	V
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = 5\text{V}, I_C = 4\text{A}$	3.5	—	12	3.5	—	12	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE} = 5\text{V}, I_C = 4\text{A}$	—	—	2	—	—	2	V
下降時間	t_f	$I_C = 3\text{A}, I_{B1} = -I_{B2} = 1\text{A}, V_{CC} = 250\text{V}$	—	—	0.5	—	—	0.5	μs